高サージ耐量版 抵抗入りトランジスタ



抵抗入りトランジスタの高サージ耐量Ver.!!

RT1N/PXXXAM1 シリーズ

□特長

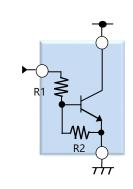
本製品はバイアス抵抗を内蔵したトランジスタの高サージ耐量品となります。

従来の抵抗入りトランジスタにおいて「高サージ耐量品が欲しい」とのお客様のご要望にお応えして、サージ耐量を向上させております。高サージ耐量品は、従来品と同等の電気的特性・等価回路でありながら、サージ耐量を大幅にアップさせ、最大150%UP(※1)を実現しております。

第1弾として下記8機種のラインナップを揃えており、 順次、バイアス抵抗、パッケージのラインナップを展開していく計画です。 さらなるサージ耐量向上版のシリーズも開発を進めておりますので、 ご期待ください。

※1 当社製品比較。従来同シリーズ品比較での最大の製品の値となります。

□内部等価回路



□サージ耐量(人体モデル)



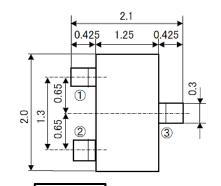
高サージ耐量品の数値は、従来品を 100とした場合の数値となります。

□製品ラインナップ

製品形名	極性	内蔵抵抗(※2)		VCEO	IC	パッケージ
		R1	R2	(※3)	(※3)	ハッケーシ
RT1N441AM1	NPN	47kΩ	47kΩ	50V	100mA	SC-70
RT1P441AM1	PNP					
RT1N141AM1	NPN	10kΩ	10kΩ			
RT1P141AM1	PNP					
RT1N241AM1	NPN		22kΩ			
RT1P241AM1	PNP					
RT1N144AM1	NPN		47kΩ			
RT1P431AM1	PNP	4.7kΩ	4.7kΩ			

- ※2 抵抗の絶対精度は±30%、相対精度は±10%(従来品同等)になります。
- ※3 内蔵トランジスタの定格値となります。

□外形図/ピン配置図



- ①ベース ②エミッタ ③コレクタ
- ※単位: mm
- ※パッケージ: SC-70